

# [补充信息]

# 多级结构 CoNiO<sub>2</sub>/TiN 复合纤维的制备及电化学性能

刘盼 1,2, 朱彬 1,2, 吕东风 1,2, 崔帅 1,2, 崔燚 1,2, 魏颖娜 1,2, 魏恒勇 1,2,∞, 卜景龙 1,2

1 华北理工大学材料科学与工程学院, 唐山 063009

2 河北省无机非金属材料重点实验室, 唐山 063009

## [Supplementary Information]

# Fabrication of CoNiO<sub>2</sub>/TiN Composite Fibers with Hierarchial Structure and Their Electrochemical Performance

LIU Pan<sup>1,2</sup>, ZHU Bin<sup>1,2</sup>, LYU Dongfeng<sup>1,2</sup>, CUI Shuai<sup>1,2</sup>, CUI Yi<sup>1,2</sup>, WEI Yingna<sup>1,2</sup>, WEI Hengyong<sup>1,2,\infty</sup>, BU Jinglong<sup>1,2</sup>

1 College of Material Science and Engineering, North China University of Science and Technology, Tangshan 063009, China

2 Key Laboratory for Inorganic Nonmetallic Materials of Hebei Province, Tangshan 063009, China

### 实验试剂与仪器

钛酸四丁酯、N, N-二甲基甲酰胺(DMF)、硝酸镍(Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O)、硝酸钴 (Co(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>·6H<sub>2</sub>O)、尿素为分析纯,购自国药集团化学试剂有限公司;聚乙烯吡络烷酮(PVP, *M*<sub>w</sub>=1 300 000)购自阿拉丁试剂有限公司;无水乙醇、冰醋酸为分析纯,购自天津市永大化学试剂 有限公司;氨气纯度为 99.999%,氮气纯度为 99.99%,购自唐山市路北区万嘉气体经销处。

物相测试分析采用日本理学株式会社产 D/MAX2500PC 型 X 射线衍射仪(XRD);样品表面的 各元素及价态分析采用美国 PHI 公司的 PHI5300C ESCA System(经过美国 RBD 公司升级) X 射线 光电子能谱;利用 XPS Peak 4.1 软件进行分峰拟合;观测所合成纤维的微观形貌采用 FEI 捷克有限 公司的 Scios 型聚焦离子束场发射扫描电子显微镜(SEM),并利用其自带的 EDS-EBSD 系统进行 能谱分析;纤维的吸附-脱附曲线测定及孔径分布测试采用中国贝世德 3H-2000PH 型全自动比表面积 分析仪。

将上述制备的 TiN 纤维与 CoNiO₂/TiN 复合纤维作为活性物质与乙炔炭黑和聚偏氟乙烯 (PVDF)按质量比 16:3:1 混合均匀后涂在泡沫镍上,于 80 ℃干燥 24 h,利用压片机于 10 MPa 下 压制成型。利用两个质量几乎相同的电极组装为 LIR2032 纽扣式超级电容器,电解液为 1 mol/L KOH 水溶液,隔膜为聚丙烯。采用上海辰华 CHI604E 电化学工作站和武汉蓝电电子 CT2001A 蓝电 电池测试系统,利用循环伏安(CV)法、交流阻抗法(EIS)和恒流充放电(GCD)法等对所合成 粉体电化学性能进行表征。

### 水热法简介

水热法是指在密封的压力容器中,以水或其他液体作为介质,在高温(大于 100 ℃)高压(大于



9.8 MPa)等条件下制备无机化合物晶体或纳米结构的一种化学合成方法。水热法操作简单、成本低、污染小,生长易控制,被广泛应用于复合材料的制备。水热法可以在纤维基底上生长不同形貌的晶粒如纳米线等,增大材料的比表面积,使得电极暴露的活性位点数量增加,电解质的有效传质和响应速率加快。另外,纳米线构成的网络框架增大了电子传输速度,提高电容器储能效率。利用水热法制备 CoNiO<sub>2</sub>/TiN 复合纤维,合成示意图如图 S1 所示。



S1 TiN 纤维及 CoNiO<sub>2</sub>/TiN 复合纤维合成示意图

Fig.S1 Schematic diagram of synthesis of TiN fibers and CoNiO<sub>2</sub>/TiN composite fibers

## 赝电容计算方法

```
取 CV 曲线中相同电压下不同扫描速率(v)下的电流值(i),由式(S1)和式(S2)

i(V)=k<sub>1</sub>v+k<sub>2</sub>v<sup>1/2</sup>
(S1)

i(V)/v<sup>1/2</sup>=k<sub>1</sub>v<sup>1/2</sup>+k<sub>2</sub>
(S2)

印 i/v<sup>1/2</sup>呈线性关系,通过在不同电位下绘制 i(V)/v<sup>1/2</sup> 与v<sup>1/2</sup>关系图,如图 S2 所示。
```

可知 *ilv*<sup>1/2</sup> 与*v*<sup>1/2</sup> 呈线性关系,通过在不同电位下绘制 *i*(*V*)/*v*<sup>1/2</sup> 与*v*<sup>1/2</sup> 关系图,如图 S2 所示。可以从直 线计算 *k*<sub>1</sub> (斜率)和 *k*<sub>2</sub> (截距)的值,帮助量化电容效应和扩散控制插入电流在特定电位下的电流分 数,在整合封闭的 CV 区域,可以区分来自不同能量存储模式的存储电荷量,由式(S3)表示:

(S3)

 $Q = Q_{\rm s} + Q_{\rm d}$ 

式中: Q、Q<sub>s</sub>和 Q<sub>d</sub>分别表示在设定扫描速率的封闭 CV 区域中总存储电荷、氧化还原反应储存电 荷、双电层储存电荷。将拟合得到的 k<sub>1</sub>带入式(S1)可得到氧化还原反应所产生的电流,绘制不同 电压下赝电容电流的 CV 曲线,计算氧化还原反应电荷储存占总电荷储存的分数,从而计算赝电容在 总电容量中的比例。





